

### 关键指标

频率: 8~12GHz  
 饱和输出功率: 30.5dBm@Pin=12dBm  
 功率附加效率: 27%@Pin=12dBm  
 功率增益: 18dB@Pin=12dBm  
 小信号增益: 22dB  
 电压/静态电流: +8V/330mA  
 芯片尺寸: 2.1mm×1.1mm

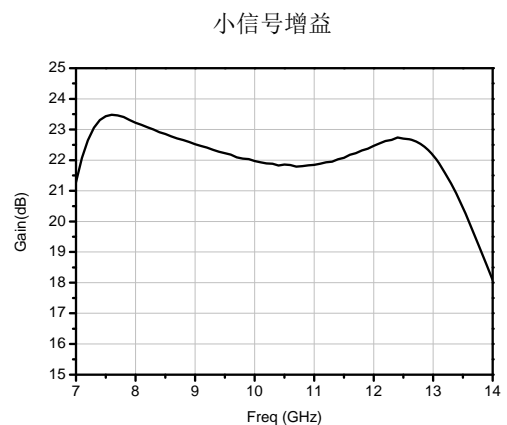
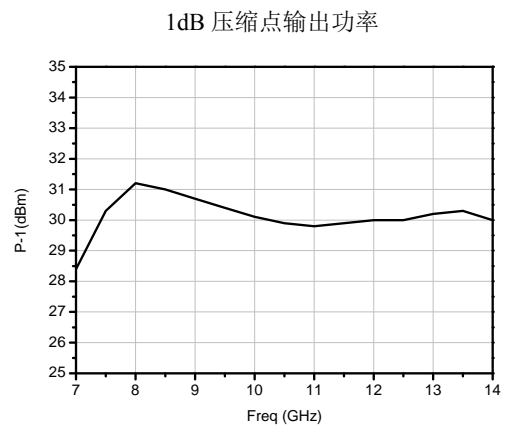
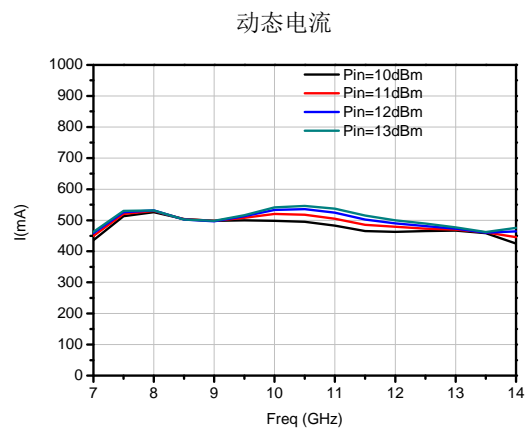
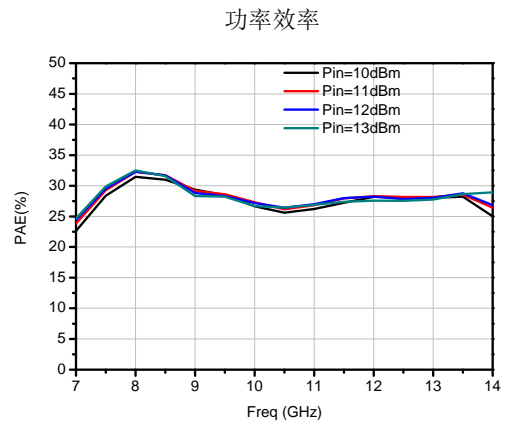
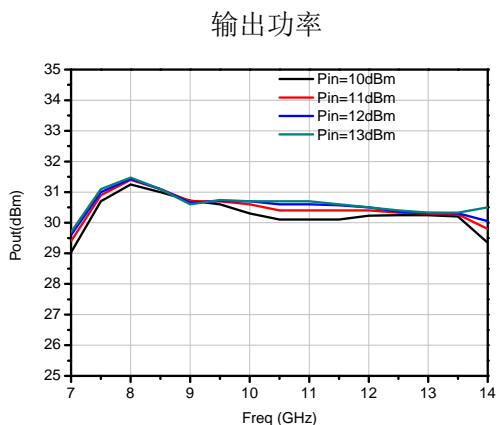
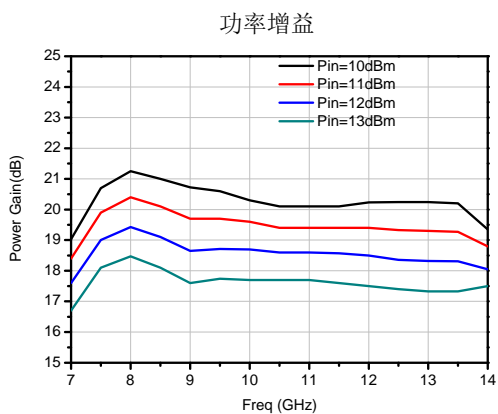
### 产品简介

HG135F6A 是一款 8~12GHz 功率放大器芯片，饱和输出功率为 1W，采用双电源供电，输入输出端已集成隔直电容。

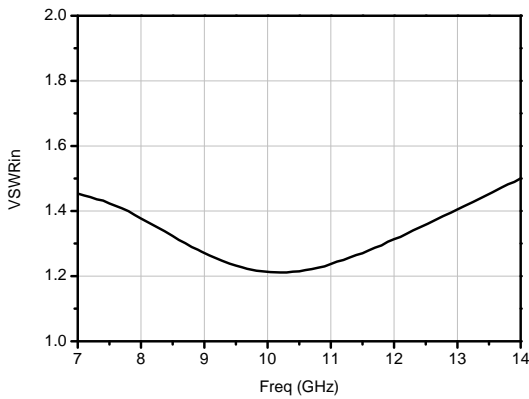
电性能 ( $T_A=25^\circ\text{C}$ ,  $V_D=8\text{V}$ ,  $V_G=-0.6\text{V}$ ,  $I=330\text{mA}$ , Pin=12dBm, 连续波)

指标	最小值	典型值	最大值
频率(GHz)	8~12		
小信号增益(dB)	-	22	-
增益平坦度(dB)	-	$\pm 0.5$	-
输入驻波	-	1.6	-
饱和输出功率(dBm)	-	30.5	-
功率附加效率(%)	-	27	-

### 典型测试曲线



输入驻波



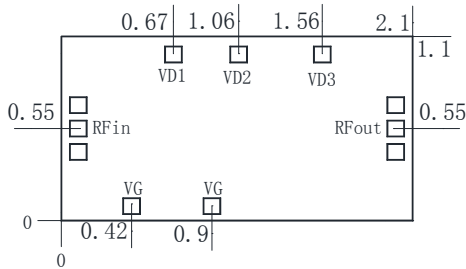
绝对额定最大值

电源电压	+10V
最大输入功率	+20dBm
工作温度	-55℃~85℃
存储温度	-65℃~150℃

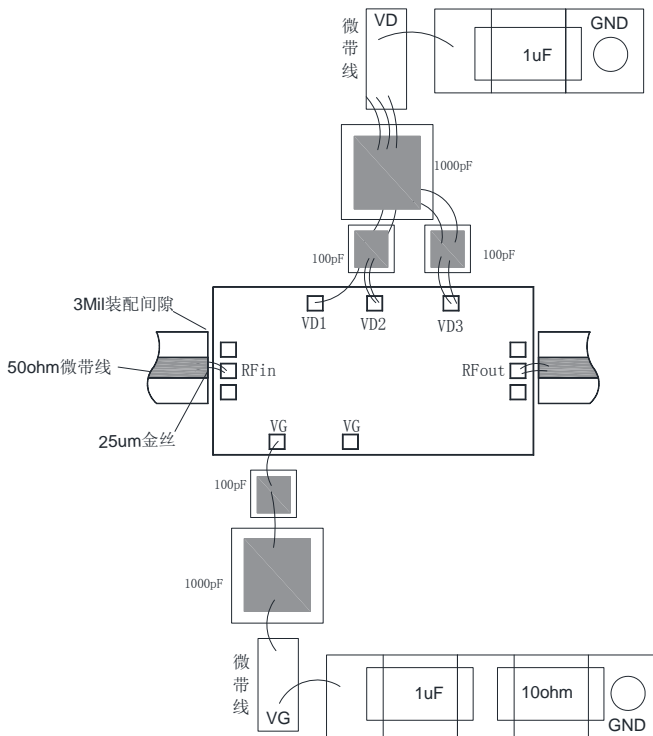
注意事项

1. 芯片在干燥、氮气环境中存储，在超净环境使用；
2. GaAs 材料较脆，不能触碰芯片表面，使用时必须小心；
3. 芯片用合金烧结（合金温度不能超过 300℃，时间不能超过 30 秒），使之充分接地；
4. 芯片微波端口与基片间隙不超过 0.05mm，使用 50μm 双金带键合，建议金带长度 250~400μm；
5. 芯片微波端有隔直电容；
6. 芯片对静电敏感，在储存和使用过程中注意防静电。

外形和端口尺寸 (mm)



推荐装配图



备注：两处 VG 任选一处加负电即可。